



# PLD808-500mW-M

## 激光二极管

产品说明书



## ■ 应用范围

泵浦源、医疗、目标指示、测量仪器、传感器。

## ■ 主要特点

有源区应变量子阱结构、高效率、高可靠性。

## ■ 封装形式

T05.6标准管壳封装。

## 1、产品简介

PLD808-500mW-M型连续激光二极管是一种以 GaAs 量子阱为有源区，发光区宽度 50 $\mu$ m 的高功率边发射半导体激光二极管芯片。具有精确波长控制、低阈值电流和高可靠腔面镀膜等特点。

## 1、参数极值

参数	符号	极值	单位
最大出光功率	$P_o$	850	mW
工作温度	$T_{op}$	-15~ 40	°C
存储温度	$T_{stg}$	-40 ~ 125	°C
最大正向电流	$I_F$	1000	mA

## 2、产品典型参数 (@ $T_c=22\pm 3^\circ C$ )

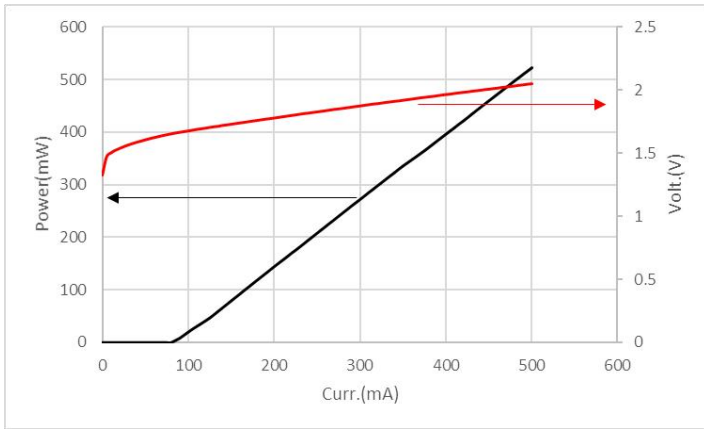
参数名称	符号	最小.	典型	最大.	单位
输出功率	$P_{op}$	—	500	—	mW
工作波长	$\lambda$	805	808	811	nm
光谱半宽	FWHM	—	—	3	nm
阈值电流	$I_{th}$	—	90	110	mA
工作电流	$I_{op}$	—	480	510	mA
工作电压	$V_{op}$	—	2.0	2.3	V
快轴发散角(FWHM)	$\theta_{\perp}$	—	33	—	Deg
慢轴发散角(FWHM)	$\theta_{//}$	—	10	—	Deg

注1：上表均为额定出光功率 500mW 下光电参数；

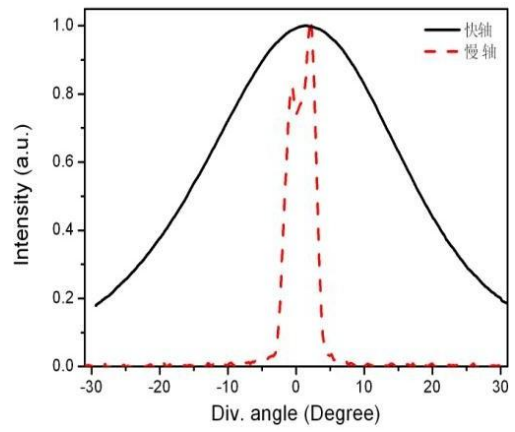
注2：发散角  $\theta_{\perp}$  及  $\theta_{//}$  均为半峰宽 ( FWHM ) 。



3、测试曲线：



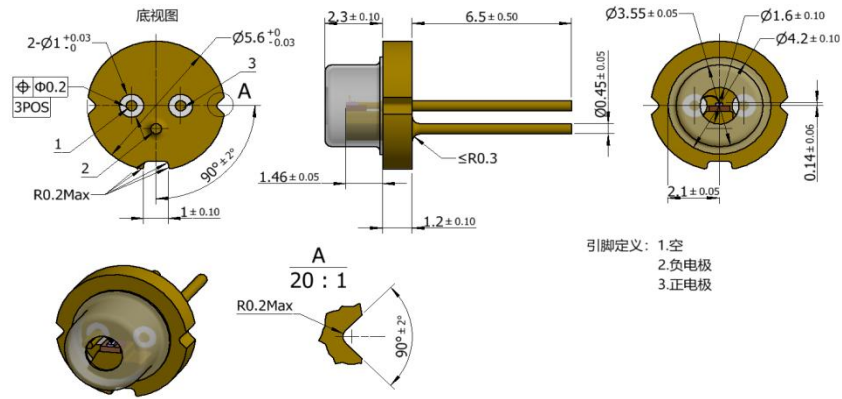
LIV 曲线



远场发散角



4、外形尺寸:



5、注意事项:

- 1)、本系列产品为三类激光产品, 激光器工作时, 避免激光照射眼睛和皮肤。
- 2)、运输、储存、使用时必须采取防静电措施。
- 3)、请避免在结露环境中使用和保存。
- 4)、如果您有任何要求请及时联系我们。

